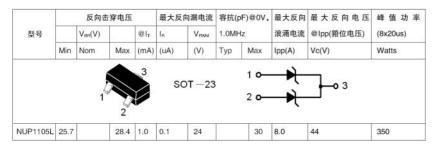
TVS/ESD保护器件

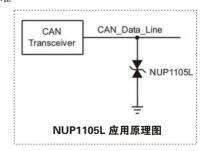
许多开发人员都遇到过这样的情况:在实验室开发好的产品,测试完全通过,但到了客户手里用了一段时间之后,出现异常现象,甚至是产品失效需要返修,并且故障率往往也不高(1%以下)。一般情况下,以上问题大都由于浪涌冲击、ESD冲击等原因造成,安森美半导体提供多种类型的电路保护器件,使您不用再为以上问题烦恼。

超小SOT953封装4通道NUP45V6系列,可以对无线产品、手持产品及其他产品进行保护;低容抗的NUP2202及NUP4202,可以应用于USB2.0高速通信设备中;NUP1105L及NUP2105L可以保护您的LIN总线及CAN总线;双通道的SM系列可以应用于RS232、RS485总线上。

NUP1105L LIN Bus保护器件

SOT-23单通道TVS/ESD保护器件, 峰值350W(8 x 20us); 符合IEC61000-4-2, Level 4标准

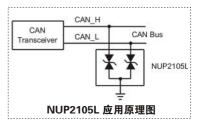




NUP2105L CAN Bus保护器件

SOT-23双通道TVS/ESD保护器件, 峰值350W(8 x 20us); 符合IEC61000-4-2, Level 4标准

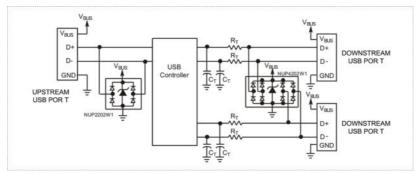
		反向击	穿电压		最大反	向漏电流	容抗(p	F)@0V,	最大反向	最大反向电压	峰值功率
型号		V _{BR} (V)		@I _T	I _R	V _{RWM}	1.0MH	łz	浪涌电流	@Ipp(箝位电压)	(8x20us)
	Min	Nom	Max	(mA)	(uA)	(V)	Тур	Max	Ipp(A)	Vc(V)	Watts
				•			4	~ 6	2		
		1	2	3	SOT -	-23	1 2	• 	*	—o 3	



安森美USB保护器件

符合IEC61000-4-2, Level 4标准

		反向:	击穿电压		最大	反向漏电流	容抗(pF)@0V,	最大反向	最大反向电压	峰值功率
型号		V _{BR} (V)		@I _T	I _B	VRWM	1.	.OMHz	浪涌电流	@lpp(箝位电压)	(8x20us)
	Min	Nom	Max	(mA)	(uA)	(V)	Тур	Max	Ipp(A)	Vc(V)	Watts
NUP4202W1		1.1									
			6	54 123	so	C-88	V _N 2 [# • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5V _P		
NUP4202W1T2G	6.0	20	=	1.0	5.0	5.0	3.0	5.0	28	20	500
NUP2202W1						100					
			6	14 123	sc-	88	V01 V _N 2 N/C3		= 6 VO = 5 V _P = = 4 N/C		
NUP2202W1	6.0	20	2	1.0	5.0	5.0	3.0	5.0	28	20	500



NUP2202及 NUP4202应用原理图

NZQA5V6AXV5计算机设备保护器件

符合IEC61000-4-2, Level标准(应用场合: 计算机、打印机、通讯系统、医疗设备)



		反向击:	穿电压		最大反向	最大反向漏	最大反向浪涌	最大反向电压	容抗
型号		V _{BR} (V)		@I _T	工作电压	电流	电流	@lpp(箝位电压)	(pF)
	Min	Nom	Max	(mA)	V _{EWM} (V)	I _R (uA)	lpp(A)	V _c (V)	(pF)
		T-553	10—) 20——)	+					
NZQA5V6AXV5T1G	5.3	5.6	5.9	1.0	3.0	1.0	1.6	13	13

NUP4114HMR6数字视频与多媒体接口保护器件

		反向击	穿电压		最大反向	最大反向漏	最大反向浪涌	最大反向电压	容抗
型号		V _{BR} (V)		@l _T	工作电压	电流	电流	@lpp(箝位电压)	(pF)
	Min	Nom	Max	(mA)	V _{EWM} (V)	I _R (uA)	Ipp(A)	V _c (V)	(pF)
	_			UO1 HT	1 610				
9	TI.	Ī		V _N 2	5 Vp				
	400			103	410	10	98		
NUP4114HMR6T1G	6.0	7.5		1.0	5.0	1.0	19	10	1.0

单通道TVS/ESD保护

SOD-23单通道TVS/ESD保护器件, 峰值350W(8 x 20us); 符合IEC61000-4-2, Level 4标准

		反向击	穿电压		最大反向 工作电压	最大反向漏 电流	最大反向浪涌	最大反向电压	容抗
型号		V _{BR} (V)		@I _T			电流	@lpp(箝位电压)	(pF)
	Min	Nom	Max	(mA)	V _{RWM} (V)	I _R (uA)	Ipp(A)	V _c (V)	(pF)
	,5	2	CASE 477 STYLE 1 SOD-323	1 0	0 2	2	CASE 477 STYLE 1 1 0— SOD-323	→ (2	
SD05(单向)	6.2	6.75	7.3	1.0	5.0	10	24	14.5	350
SD05(单向) SD12(单向)	6.2 13.3	6.75 14.5	7.3 15.75	1.0 1.0	5.0 12	10 1.0	24 15	14.5 25	350 150

SOD-923单通道TVS/ESD保护器件, 峰值100W(8 x 20us); 符合IEC61000-4-2, Level 4标准

		反向击	穿电压		最大反向工	最大反向漏	最大反向	最大反向电压	容抗
型号		V _{BR} (V)		@l _T	作电压	电流	浪涌电流	@lpp(箝位电压)	(pF)
	Min	Nom	Max	(mA)	V _{FMM} (V)	I _R (uA)	Ipp(A)	V _c (V)	(pF)
					CASE 514AA SOD-923	1 0	0 2		
ESD9X3.3S	5.0		-	1.0	3.3	2.5	9.8	10.4	80
ESD9X5.0S	6.2	-	-	1.0	5.0	1.0	8.7	13.3	65
ESD9X12S	13.5	-0	-	1.0	12	1.0	5.9	23.7	30

双通道TVS/ESD保护

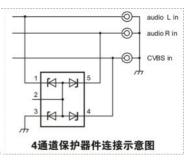
SOT-23双通道TVS/ESD保护器件, 峰值300W(8 x 20us); 符合IEC61000-4-2, Level 4标准

		反向击	5穿电压		最大反向工作	最大反向漏	最大反向	最大反向电压	容抗
型号		V _{BR} (V)		@I _T	电压	电流	浪涌电流	@lpp(箝位电压)	(pF)
	Min	Nom	Max	(mA)	V _{FRMM} (V)	I _R (uA)	Ipp(A)	V _c (V)	(pF)
					CASE 318 STYLE 12 LOW PROFILE SOT-2 PLASTIC	23 2 0 1	→ 3		
SM05	6.2	6.75	7.3	1.0	5.0	10	17	9.8	225
	13.3	14.5	15.75	1.0	12	1.0	12	19	95

四通道低容抗TVS/ESD保护器件

SOT-953封装,符合IEC61000-4-2, Level 4标准

型号	反向击穿电压 V _{BR} @1.0mA(V)			漏电流 I _{RM} @V _{RM}			t@0V偏置 pF)	典型容抗@3V 偏置(pF)	
51 - 546	Min	Nom	Max	V _{RWM}	I _{RWM} (uA)	Тур	Max	TYP	Max
				SOT-95	3	2 ⊶	-	9 4	
		_		0.0			0.4 -4	7.0	
NUP45V6P5	5.3	5.6	5.9	3.0	1.0	13	17	7.0	11.5
NUP45V6P5 NUP46V8P5	5.3 6.47	5.6 6.8	7.14	4.3	1.01	13	17	6.7	9.5



防雷保护器件

NP系列(低电容/低电压)过压保护芯片,保护高速xDSL驱动器及其他芯片免受雷击和ESD冲击的损害。内部极低的漏电流使其非常适合应用于低压高速的场合,芯片拥有低容抗特性,可使高速数据无损通过保护系统。

先进的硅结构技术使NP系列产品拥有最小化的尺寸,能够快速应对ESD冲击、高能量浪涌冲击。



芯片特性

- 低容抗特性;
- 小封装尺寸;
- 极低的差分电容;
- 双向操作;
- 低漏电流;
- 直通布局;
- 高抑制浪涌能力;
- 符合IEC 61000-4-2 Level 4 ESD标准;
- 精准的电压箝位功能;
- 无铅封装。

NP系列芯片应用示意图

应用方向

VDSL、ADSL, 消费类终端设备, 网关, 以太网设备, RS232、RS485设备

防雷保护器件选型表

型号	VRVM	V_{BR}	I _R @V _R =V _{RWM}	C@V _R =2V	Δ°C 0V−V _{RWM}	冲击峰值电流@ 8x20us
	(V)	(V)	(uA)	(pF)	(pF)	(A)
	5	D.C.	TSOP-5			2 Z 4
		1				
NP0080TAT1G	8	9.5	0.5	13	4	50
NP0080TAT1G NP0120TAT1G		1	0.5 0.5	13 11	3	50